



SLS SEMICONDUCTOR (SHENZHEN) CO.,LTD.

**SOT-23 封装半导体二极管/SOT-23 Plastic-Encapsulate Diodes**

# 1SS181 ( SWITCHING DIODE )

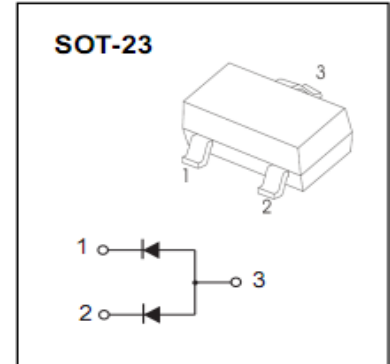
## 特点/Features:

- 低导通压降;
- 反向恢复时间短

## 用途/Applications:

- 高速开关电路。

## 印章/Marking: A3



## 极限参数/Absolute maximum ratings (Ta=25°C)

参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
反向峰值电压/Non-Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RM}$	85	V
反向电压/Reverse Voltage	$V_R$	80	V
正向连续电流/Forward Continuous Current	$I_F$	300	mA
平均整流输出电流/Average Rectified Output Current	$I_O$	100	mA
功率/ Power Dissipation	$P_D$	0.15	W
结温/Junction Temperature	$T_j$	150	°C
储存温度/Storage Temperature	$T_{stg}$	-55~150	°C

## 电性能参数/Electrical characteristics (Ta=25°C)

参数/Parameter	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
反向击穿电压 Reverse Breakdown Voltage	$V_R$	$I_R=100 \mu A$	80			V
正向电压 Forward Voltage	$V_{F1}$	$I_F=1mA$		0.61		V
	$V_{F2}$	$I_F=10mA$		0.74		V
	$V_{F3}$	$I_F=100mA$		0.92	1.2	$\mu A$
反向漏电流 Reverse Current	$I_{R1}$	$V_R=30V$			0.1	$\mu A$
	$I_{R2}$	$V_R=80V$			0.5	$\mu A$
端电容 Capacitance Between Terminals	$C_T$	$V_R=0, f=1MHz$		2.2	4.0	pF
反向恢复时间 Reverse Recovery Time	$t_{rr}$	$I_F=I_R=10mA,$ $I_{rr}=0.1 \times I_R$		1.6	4.0	nS



### 典型特性曲线图/Typical Characteristics

